








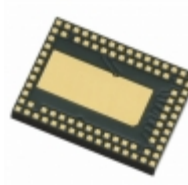
	<h2 style="color: red;">SI1031X-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI1031X-T1-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 0.155A SC-75A
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1031X-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 15000 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI1031X-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 0.155A SC-75A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	15000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 155mA (Ta) 300mW (Ta) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-75A
Supplier Device-Gehäuse	SC-75A
Verlustleistung (max)	300mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	155mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 Ohm @ 150mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.5nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±6V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI1031X-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1031X-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1031X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1031X-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1031R-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 0.14A SC-75A</p>	 <p><b>SI1031X</b> VISHAY SI1031X VISHAY</p>	 <p><b>SI1032-A-GM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p><b>SI1031X-T1</b> VISHAY SI1031X-T1 VISHAY</p>
 <p><b>SI1031X-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 0.155A SC-75A</p>	 <p><b>SI1031X-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 0.155A SC-75A</p>	 <p><b>SI1032-A-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p><b>SI1032-B-GM3</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 85-VFLGA</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ SI1024X-T1-E3	↔ SI1024X-T1-E3	⇒ SI1024X-T1-GE3	D SI1024X-T1-GE3	⇒ SI1024X-T1-GE3
⊕ SI1025X-T1	⊕ SI1025X-T1-E3	D SI1025X-T1-E3	⇒ SI1026X-T1	⇒ SI1026X-T1-E3
⊕ SI1026X-T1-E3	⊕ SI1026X-T1-GE3	⊕ SI1026X-T1-GE3	↔ SI1028X-T1-GE3	⇒ SI1028X-T1-GE3
D SI1029X-T1-GE3	⊕ SI1029X-T1-GE3	⊕ SI1031R-T1	⊕ SI1031R-T1-E3	⇒ SI1031R-T1-E3
⇒ SI1031R-T1-GE3	↔ SI1031R-T1-GE3	⊕ SI1031X-T1	⊕ SI1031X-T1-E3	⇒ SI1031X-T1-E3
↔ SI1031X-T1-GE3	⇒ SI1032R-T1	D SI1032R-T1-E3	⊕ SI1032R-T1-E3	⊕ SI1032R-T1-GE3
⊕ SI1032R-T1-GE3	D SI1032X-T1	⇒ SI1032X-T1-E3	↔ SI1032X-T1-E3	⇒ SI1032X-T1-GE3
⊕ SI1032X-T1-GE3	⊕ SI1033X-T1	↔ SI1033X-T1-E3	⇒ SI1033X-T1-E3	⇒ SI1034CX-T1-GE3
⊕ SI1034CX-T1-GE3	⊕ SI1034X-T1	⊕ SI1034X-T1-E3	D SI1034X-T1-E3	⇒ SI1034X-T1-GE3
↔ SI1034X-T1-GE3	⊕ SI1035X-T1	⊕ SI1035X-T1-E3	⊕ SI1035X-T1-E3	⇒ SI1035X-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited